

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0713-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Elektrotechnický ústav, Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

IČO: 00598429

DIČ: SK2020795821

Bankové spojenie a číslo účtu: 7000253587/8180

v zastúpení: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.; riaditeľ EIÚ SAV

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Jozef Huran, CSc.; samostatný vedecký pracovník

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0713-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev moderných polovodičov pre mikroelektroniku a optoelektroniku“ č. APVV-0713-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 31.05.2011.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Závěrečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 22.11.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O.BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132583



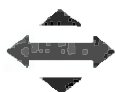
Lyana Čučková
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Bratislave, dňa 8.11.2010

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9



Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Depozícia tenkých vrstiev karbidu kremíka, nitridu karbidu kremíka, amorfneho uhlíka a uhlíka podobného diamantu plazmovou depozíciou a charakterizácia štruktúrnych, elektrických a optických vlastností	09.2008	04.2009
2	Reaktívne magnetronové naprašovanie tenkých vrstiev uhlíkových zlúčenín navrhnutých v projekte(1. etapa). Štruktúrna, elektrická a optická charakterizácia pripravených tenkých vrstiev	02.2009	04.2010
3	Príprava modifikovaných tenkých vrstiev uhlíkových zlúčenín dopovaním. Charakterizácia tenkých vrstiev. Návrh a technológia modelových štruktúr	04.2010	05.2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Thin film deposition of silicon carbide, silicon carbon nitride, amorphous carbon and diamond like carbon by plasma deposition and characterization of structural, electrical and optical properties	09.2008	04.2009
2	Reactive magnetron sputtering of carbon alloys proposed in project(1. phase). Structural, electrical and optical characterization of prepared thin films	02.2009	04.2010
3	Preparation of modified carbon alloy thin films by doping. Characterization of thin film properties. Design and technology of modeling structures	04.2010	05.2011